

## Módulo de Memória "Unbuffered" de 1 GByte

### MW01GN6625UA8

1 GigaByte, DDR2, PC2-5300 (667 MHz), CL5 DIMM 240 Pinos

### MW01GN8026UA8

1 GigaByte, DDR2, PC2-6400 (800 MHz), CL5 DIMM 240 Pinos

#### Descrição:

Os produtos **MW01GN6625UA8/MW01GN8026UA8** são Módulos de Memória de 1 Gigabyte, organizados como uma memória DRAM DDR2 de 128Mx64 bits. Cada módulo é composto por oito CIs de DRAM DDR2 128Mx8 em encapsulamento FBGA e uma EEPROM serial na função de SPD (Detecção de Presença Serial — *Serial Presence Detect*), montados em um módulo DIMM de 240 pinos, com contatos dourados, segundo o padrão JEDEC.

#### Características:

- Mecânica DIMM de 240 pinos, *unbuffered*;
- Arquitetura DDR2 (*Double Data Rate*); duas transferências de dados por ciclos de clock;
- Controle da terminação no *Die*;
- Utiliza DRAMs DDR2 na organização 128Mx8;
- Entradas de *clock* diferenciais;
- Tamanho de *burst* programável: 4 ou 8
- Tempo de ciclo de *clock* (MW01GN6625UA8)
  - ( $t_{CK}$ ) = 3,00 ns (mín.) / 8 ns (máx.) @ CL=5
- Tempo de ciclo de *clock* (MW01GN8026UA8)
  - ( $t_{CK}$ ) = 2,50 ns (mín.) / 8 ns (máx.) @ CL=6
- EEPROM para Detecção de Presença Serial (SPD)
- *Strobe* de dados bidirecional e diferencial (sinais DQS e /DQS)
- Oito bancos internos às DRAMs para operação concorrente;
- Tempo de *Auto-Refresh* para estado Ativo ( $t_{RFC}$ ): 127,5 ns (mín)
- Auto precarga
- Modos de *Auto-refresh* e *Self-refresh*
- Endereços de linha: A<sub>0</sub>-A<sub>13</sub>
- Endereços de coluna: A<sub>0</sub>-A<sub>9</sub>
- Endereços de Banco: BA<sub>0</sub>~BA<sub>2</sub>
- Interface SSTL\_18
- VDD = VDDQ = 1,8 V ± 0.1 V

#### Especificações:

Símbolo	Característica AC	Mín.	Máx.	Unid.	
$t_{CK}$	Tempo de Ciclo de <i>Clock</i>	MW01GN6625UA8 CL=5	3000	8000	ps
		MW01GN8026UA8 CL=6	2500		
$t_{RC}$	Tempo de Ciclo de Linha (Operação)	MW01GN6625UA8	57	-	ns
		MW01GN8026UA8	57,5		
$t_{RAS}$	Tempo de Linha Ativa	45	70000	ns	
$t_{RFC}$	Tempo de Auto Refresh para Ativo / Tempo de Comando de Auto Refresh	127,5	-	ns	
			<b>Valor</b>	<b>Unid</b>	<b>Cond.</b>
Dissipação de Potência, Operando (Ativação de Linha, Precarga) @VDD, VDDQ = 1.8V		MW01GN6625UA8	2,592	W	Ta=25°C
		MW01GN8026UA8	2,664		
Temperatura de Operação <sup>1</sup>			0 ~ 85	°C	
Temperatura de Armazenagem			-55 ~ 100	°C	

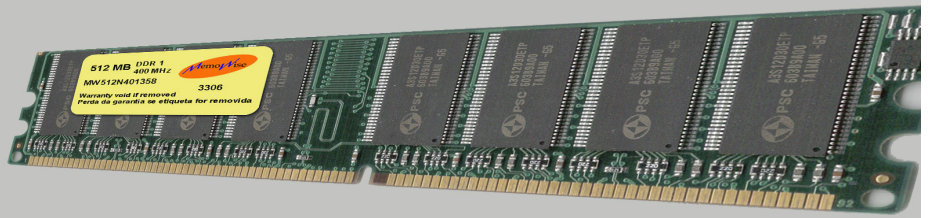
Nota:

1. Refere-se à temperatura no encapsulamento dos CIs de DRAM

Todos os valores nesta folha de dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A MemoWise não assume nenhuma responsabilidade pelo uso desta informação, nem pela infração de patentes ou outros direitos de terceiros que possam resultar de seu uso.

#### AVISO: NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À VIDA

NÃO SE AUTORIZA O USO DOS PRODUTOS MEMOWISE COMO COMPONENTES CRÍTICOS EM DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE SUPORTE À VIDA SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DE MEMOWISE TECNOLOGIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.



**Módulo de Memória "Unbuffered" — MW01GN6625UA8 / MW01GN8026UA8**

**Dimensões**

Todas as dimensões estão em milímetros (polegadas); a tolerância é  $\pm 0.127$  (0.005") exceto onde indicado.

